

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 5 月 1 日(01.05.2014)



(10) 国際公開番号
WO 2014/065201 A1

- (51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) *C22C 5/04* (2006.01)
B22F 3/14 (2006.01) *C22C 38/00* (2006.01)
C22C 1/05 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/078264
- (22) 国際出願日: 2013 年 10 月 18 日(18.10.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-233999 2012 年 10 月 23 日(23.10.2012) JP
- (71) 出願人: J X 日鉱日石金属株式会社(JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008164 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 3 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 荻野 真一(OGINO Shin-ichi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町臼場 1 8 7 番地 4 J X 日鉱日石金属株式会社 磯原工場内 Ibaraki (JP).
- (74) 代理人: 小越 勇, 外(OGOSHI Isamu et al.); 〒1050001 東京都港区虎ノ門 2 丁目 9 番 1 4 号 発明会館 5 階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

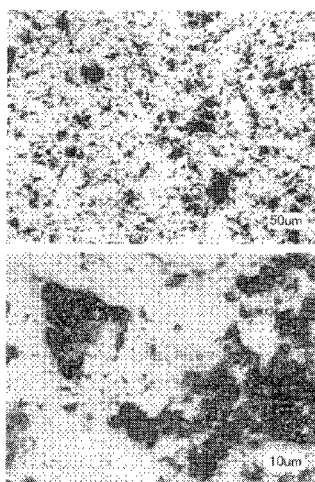
添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: Fe-Pt SINTERED COMPACT SPUTTERING TARGET AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR

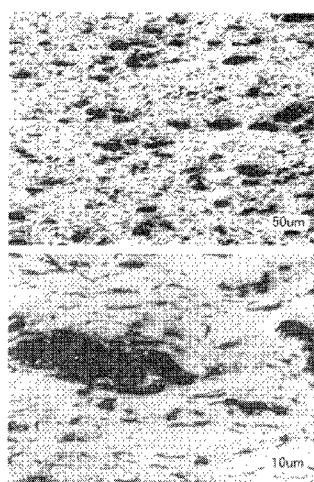
(54) 発明の名称: F e - P t 系焼結体スパッタリングターゲット及びその製造方法

[図1]



水平面
AA

AA Level surface



垂直断面
BB

BB Perpendicular cross-section

(57) Abstract: An Fe-Pt sintered compact sputtering target containing BN characterized in that the intensity ratio of the X-ray diffraction peak intensity of a hexagonal BN (002) plane in a plane level with the sputtering surface with respect to the X-ray diffraction peak intensity of a hexagonal BN (002) plane in a cross-section perpendicular to the sputtering surface is 2 or more. The present invention addresses the problem of providing a sputtering target with which manufacture of a magnetic film in thermally assisted magnetic recording media is possible and particles that are generated during sputtering are reduced.

(57) 要約: BNを含有するF e - P t 系焼結体スパッタリングターゲットであって、スパッタ面に対して垂直断面における六方晶BN (002) 面のX線回折ピーク強度に対する、スパッタ面に対して水平面における六方晶BN (002) 面のX線回折ピーク強度の強度比が2以上であることを特徴とする焼結体スパッタリングターゲット。熱アシスト磁気記録メディアにおける磁性薄膜の

作製を可能にし、さらには、スパッタリング時に発生するパーティクルを低減したスパッタリングターゲットを提供することを課題とする。